

型 名	社 名	用 途	構 造	チ モ ー ド	最 大 定 格					電 氣 的 特 性 (Ta=25℃)														
					V*** (V)	区 分 ***	Vos* (V)	区 分 *	I* (A)	区 分 *	P <sub>D</sub> /P <sub>CH</sub> (W)	I <sub>GSS</sub> (max) (A)	V <sub>GS</sub> (V)	I <sub>PSS</sub> (min) (A)	I <sub>PSS</sub> (max) (A)	V <sub>DS</sub> (V)	V <sub>GS(off)</sub> (min) (V)	V <sub>GS</sub> (max) (V)	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (A)	(min) (S)	g <sub>m</sub> (typ) (S)	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (A)
YTF840	東芝	SW, DDC	MOS	N E	500	DSX	±20	S	8	D	125	±100n	±20		0.25m	500	2	4	VGS	250μ	4	6.5	10	4
YTF841	東芝	SW, DDC	MOS	N E	450	DSX	±20	S	8	D	125	±100n	±20		0.25m	450	2	4	VGS	250μ	4	6.5	10	4
YTF842	東芝	SW, DDC	MOS	N E	500	DSX	±20	S	7	D	125	±100n	±20		0.25m	500	2	4	VGS	250μ	4	6.5	10	4
YTF843	東芝	SW, DDC	MOS	N E	450	DSX	±20	S	7	D	125	±100n	±20		0.25m	450	2	4	VGS	250μ	4	6.5	10	4
YTFP150	東芝	SW, DDC	MOS	N E	100	DSX	±20	S	40	D	150	±100n	±20		0.25m	100	2	4	VGS	250μ	9	11	10	20
YTFP151	東芝	SW, DDC	MOS	N E	60	DSX	±20	S	40	D	150	±500n	±20		0.25m	60	2	4	VGS	250μ	9	11	10	20
YTFP152	東芝	SW, DDC	MOS	N E	100	DSX	±20	S	33	D	150	±500n	±20		0.25m	100	2	4	VGS	250μ	9	11	10	20
YTFP153	東芝	SW, DDC	MOS	N E	60	DSX	±20	S	33	D	150	±500n	±20		0.25m	60	2	4	VGS	250μ	9	11	10	20
YTFP250	東芝	SW, DDC	MOS	N E	200	DSX	±20	S	30	D	150	±100n	±20		0.25m	200	2	4	VGS	250μ	8	14	10	16
YTFP251	東芝	SW, DDC	MOS	N E	150	DSX	±20	S	30	D	150	±100n	±20		0.25m	150	2	4	VGS	250μ	8	14	10	16
YTFP252	東芝	SW, DDC	MOS	N E	200	DSX	±20	S	25	D	150	±100n	±20		0.25m	200	2	4	VGS	250μ	8	14	10	16
YTFP253	東芝	SW, DDC	MOS	N E	150	DSX	±20	S	25	D	150	±100n	±20		0.25m	150	2	4	VGS	250μ	8	14	10	16
YTFP450	東芝	SW, DDC	MOS	N E	500	DSX	±20	S	13	D	150	±500n	±20		0.25m	500	2	4	VGS	250μ	6	11	10	7
YTFP451	東芝	SW, DDC	MOS	N E	450	DSX	±20	S	13	D	150	±500n	±20		0.25m	450	2	4	VGS	250μ	6	11	10	7
YTFP452	東芝	SW, DDC	MOS	N E	500	DSX	±20	S	12	D	150	±500n	±20		0.25m	500	2	4	VGS	250μ	6	11	10	7
YTFP453	東芝	SW, DDC	MOS	N E	450	DSX	±20	S	12	D	150	±500n	±20		0.25m	450	2	4	VGS	250μ	6	11	10	7
μPA33A	NEC	DC, Chop	MOS	P	-30	DSS	±30	S	-20m	D	0.1/CH	-10n	-10				-2.5	-5.5	-10	-10μ	1m	2m	-10	-1m
μPA34A	NEC	DC, Chop	MOS	N	20	DSS	±30	S	10m	D	100m	10n	10		2.5m	10		-5	10	50μ	0.3m	0.6m	10	1DSS
μPA50A	NEC	LF A	J	N D	-60	GDO	±60	O	10m	G	0.2/CH	-10n	-10	1.5m	18m	10	-0.3	-2.4	10	10μ	2m	4m	10	1m
μPA60A	NEC	Diff	J	N D	-40	GDO	-40	O	50m	G	.25/CH	-0.1n	-20	0.5m	5m	10	-0.2	-2.5	10	10μ	1m	2m	10	0.5m
μPA61A	NEC	Diff	J	N D	-40	GDO	-40	O	50m	G	.25/CH	-0.1n	-20	0.5m	5m	10	-0.2	-2.5	10	10μ	1m	2m	10	0.5m
μPA62C	NEC	Diff, バランスド MIX	J	N D	-20	GDO	-10	O	10m	G	350m	-50n	-8	8m	32m	10	0.35	-2.2	10	10μ	12.5m	15m	10	3m
μPA68H	NEC	LF A	J	N D	-60	GDO	-60	O	10m	G	.25/CH	-1n	-20	1.5m	20m	10	-0.3	-4.2	10	10μ	2m	4m	10	1m
μPA68H	NEC	LF LN A	J	N D	-50	GDO	-50	O	10m	G	.25/CH	-1n	-20	1m	18m	10	-0.15	-2.5	10	10μ	5m	7m	10	1m
μPA70A	NEC	DC	J	N D	-40	GDO	-40	O	50m	G	250m	-0.1n	-20	0.5m	5m	10	-0.2	-2.5	10	10μ	1m	2m	10	0.5m
μPA71A	NEC	DC	J	N D	-40	GDO	-40	O	50m	G	250m	-0.1n	-20	0.5m	5m	10	-0.2	-2.5	10	10μ	1m	2m	10	0.5m
μPA502T	NEC		MOS	N E	50	DSS	±20	S	100m	D	300m	±1μ	±20		1μ	50	0.8	1.8	5	1μ	20m		5	10m
μPA503T	NEC		MOS	P E	-50	DSS	±16	S	-100m	D	300m	±1μ	±16		-1μ	-50	-1.5	-2.5	-5	-1μ	20m		-5	-10m
μPA505T	NEC		MOS	E	±50	DSS	±16	S	±100m	D	300m	±10μ	±20		±1μ	±50								
μPA572T	NEC	SW	MOS	N E	30	DSS	±7	S	±100m	D	200m	±3μ	±5		1μ	30	0.8	1.5	3	10μ	20m	50m	3	10m

電 気 的 特 性 (Ta=25℃)											コンプリ メンタリ	外 形	備 考	型 名		
Cis (typ) (pF)	Crs (typ) (pF)	VGS (V)	VDS (V)	NF typ dB	NF max dB	f (Hz)	RG (Ω)	RDS(ON) (max) (Ω)	VGS (V)	ID (A)					そ の 他 特 性	測 定 条 件
1200	60	0	25					0.85	10	4				183	GDS	YTF840
1200	60	0	25					0.85	10	4				183	GDS	YTF841
1200	60	0	25					1.1	10	4				183	GDS	YTF842
1200	60	0	25					1.1	10	4				183	GDS	YTF843
1700	180	0	25					0.055	10	20				184	GDS	YTFP150
1700	180	0	25					0.055	10	20				184	GDS	YTFP151
1700	180	0	25					0.08	10	20				184	GDS	YTFP152
1700	180	0	25					0.08	10	20				184	GDS	YTFP153
2300	390	0	25					0.085	10	16				184	GDS	YTFP250
2300	390	0	25					0.085	10	16				184	GDS	YTFP251
2300	390	0	25					0.12	10	16				184	GDS	YTFP252
2300	390	0	25					0.12	10	16				184	GDS	YTFP253
2000	100	0	25					0.4	10	7				184	GDS	YTFP450
2000	100	0	25					0.4	10	7				184	GDS	YTFP451
2000	100	0	25					0.5	10	7				184	GDS	YTFP452
2000	100	0	25					0.5	10	7				184	GDS	YTFP453
15		0	0					500	-6		Δ Vth=0. 2V	VDS=-10V, ID=-10 μ A		22	Dual FET	μ PA33A
4		0	10								Δ IDSS=0. 1mA	VDS=10V, VGS=0		22	Dual FET	μ PA34A
5	1.3		10								Δ IDSS=10%max	VDS=10V		44	SDGC	μ PA50A
2.5	0.5	0	10								Δ VGS=5mVmax	VDS=10V, ID=0. 2mA		111	Dual FET	μ PA60A
2.5	0.5	0	10								Δ VGS=40mVmax	VDS=10V, ID=0. 2mA		111	Dual FET	μ PA61A
7.5	2.5		10	2		400M					PG=12dBtyp	f=400MHz		76	Dual FET	μ PA62C
6	1.6		10								Δ VGS=60mVmax	VDS=10V, ID=1mA		66	Dual FET	μ PA63H
15	3	0	10								Δ VGS=20mVmax, NV=35mVmax	VDS=10V, ID=1mA		66	Dual FET	μ PA68H
5max	1.5max	0	10								Δ VGS=5mVmax	VDS=10V, ID=0. 2mA		77	Dual FET	μ PA70A
5max	1.5max	0	10								Δ VGS=40mVmax	VDS=10V, ID=0. 2mA		77	Dual FET	μ PA71A
16	3	0	5								ton=27ns, toff=106nstyp	ID=10mA, VDD=5V	μ PA503T	317A	2SK ×2 ヴ-ス・コソ	μ PA502T
10	4	0	-5								ton=80ns, toff=180nstyp	ID=-10mA, VDD=-5V	μ PA502T	317B	2SJ ×2 ヴ-ス・コソ	μ PA503T
16/10	3/4	0	±5					25/60	±10	±10m	ton=27/80nstyp	ID=±10mA, VDD=±5V		317C	2SJ+2SK ヴ-ス・コソ	μ PA505T
16	2	0	5					8	4	10m	ton=35ns, toff=200nstyp	ID=10mA, VDD=5V		317A	2SK ×2 ヴ-ス・コソ	μ PA572T